# 表面処理を施したアルミニウム集電体と電極合材との接触抵抗の発現要因

加藤 直貴(山形大学大学院理工学研究科,twr36022@st.yamagata-u.ac.jp) 小野寺 伸也(山形大学大学院理工学研究科,tyt73646@st.yamagata-u.ac.jp) 伊藤 知之(山形大学大学院理工学研究科,twy67966@st.yamagata-u.ac.jp) 伊藤 智博(山形大学大学院理工学研究科,tomohiro@yz.yamagata-u.ac.jp) 立花 和宏(山形大学大学院理工学研究科,h9rbvq3x@yz.yamagata-u.ac.jp) 仁科 辰夫(山形大学大学院理工学研究科,nishina@yz.yamagata-u.ac.jp)

# Inducing factors for contact resistance between surface treated aluminum current collectors and electrode composites

Naoki Kato (Graduate School of Science and Engineering, Yamagata University, Japan) Shinya Onodera (Graduate School of Science and Engineering, Yamagata University, Japan) Tomoyuki Ito (Graduate School of Science and Engineering, Yamagata University, Japan) Tomohiro Ito (Graduate School of Science and Engineering, Yamagata University, Japan) Kazuhiro Tachibana (Graduate School of Science and Engineering, Yamagata University, Japan) Tatsuo Nishina (Graduate School of Science and Engineering, Yamagata University, Japan)

#### 要約

アルミニウム集電体と電極合材の接触抵抗は、電極合材に含まれる活物質の電気感受率とともに増加する。そこで活物質表 面電荷の影響を減少させるため、アルミニウム集電体の表面処理として粗面化による物理的アプローチと相互拡散層の形成 による化学的アプローチを試みた。その結果、特に相互拡散層の形成による静電遮蔽が接触抵抗低減に著しい効果を見出し た。

## キーワード

アノード酸化,アルミニウム,表面処理,集電体,接触抵 抗

#### 1. 緒言

リチウムイオン二次電池の内部抵抗は正極合材とアルミニ ウム集電体との接触抵抗R<sub>c</sub>、溶液抵抗R<sub>s</sub>、反応抵抗R<sub>r</sub>に分け られる。接触抵抗R<sub>c</sub>は、溶液抵抗R<sub>s</sub>の次に電池のレート特性 を左右する支配的因子である。活物質を含む合材とそうでな い合材ではアルミニウム集電体と電極合材との接触抵抗R<sub>c</sub>が 大きく異なる(Onodera et al. (submitted))。本田らはその現 象を活物質接触による空乏層(空間電荷層)の形成で説明して いる(Honda et al., 2012; 2014)。小野寺らはアルミニウム集 電体をアノード酸化して酸化皮膜Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>の厚さ*d*と、合材とア ルミニウム集電体間の接触抵抗R<sub>c</sub>の関係を調べた。その結果、 接触抵抗R<sub>c</sub>は酸化皮膜の厚さ*d*に対して直線的に増加し、式(1) で表されると述べている。

$$R_c = \rho \left( d + d_0 \right) \tag{1}$$

ここで $\rho$ は電気抵抗率( $\Omega$ ·m)である。さらに合材成分iの電 気感受率を $\chi_{ex}$ 寄与率を $c_i$ としたとき接触抵抗は式(2)で表 されると述べている。

$$R_{c} = \left(\rho_{0}\sum_{i} c_{i}\chi_{e^{i}} + \rho_{0}^{'}\right)(d + d_{0})$$
(2)

ここで電気感受率 $\chi_{ei}$ は物性値であり、比誘電率 $\epsilon$ から1を 減じて求められるが、寄与率 $c_i$ は、電極合材の組成、合材に 含まれる材料の分散状態ばかりでなくアルミニウム集電体の 表面状態によっても大きく変化する。

本研究では表面処理が集電体と電極合材との接触抵抗R<sub>c</sub>を どう低減させるか調べることを目的とする。

# 2. 実験

2.1 アルミニウム箔

表1に示すように、表面処理の異なるアルミニウム箔を準備した。a箔は粗面化処理を施したポアを設けた箔である。 またアルミニウム箔に相互拡散層を施したb箔を準備した。 サニメント手袋をしてアルミニウム箔をカッティングボードの上でカッターと1 mm 目盛りの定規を用いて図1(a)に示す旗形に切り取り、アルミニウム箔旗型電極とした。電極面積5は100 mm<sup>2</sup>とした。アルミニウムの前処理にはアルカリ脱脂あるいは何も行なわなかった。アルカリ脱脂は1 M(= mol·dm<sup>-3</sup>)のNaOH水溶液に60 s、イオン交換水に10 s、1 Mの硝酸に30 s、イオン交換水に10 s浸した。

表1:アルミニウム箔の表面処理の種類

アルミニウム箔の種類	表面処理の種類
未処理箔	表面処理無し
a箔	粗面化(大)
b箔	相互拡散層(厚)

#### 2.2 合材電極の作成

電極合材スラリーを以下の通り準備した。ディスポカップ (アズワン,10 mL)に1gのマンガン酸リチウム(平均粒子径25 µm、三井金属株式会社製、以下LiMn<sub>2</sub>O<sub>4</sub>)、0.03gの炭素アセ チレンブラック(一次粒子径30 nm、ストラクチャー0.1µm、 AB)、0.12gの8wt%ポリフッ化ビニリデン(PVDF KF7208)・ N-メチル - 2-ピロリドン(NMP)溶液、1.6gのNMPを加えた。 ペンシルミキサー(D•x, アズワン)で1分間撹拌してスラリー を作成した。

アルミニウム箔旗型電極を電極合材スラリーに浸漬し塗工 した。乾燥機(真空定温乾燥機ADP-21,ヤマト)と油回転式真 空ポンプ(PASCAL 2015SD,アルカテル)を用いて80℃で30分 乾燥を行い、その後真空引きし160℃で1時間乾燥し、合材 電極を作成した。

## 2.3 電解液

0.3M アジピン酸アンモニウム水溶液 (0.3 M AA aq) として、 1 gのアジピン酸アンモニウムを20 gのイオン交換水に溶か した。イオン交換水の導電率 $k_s$ は0.05  $\mu$ S/cmであった。有機 電解液として、1 Mの四フッ化ホウ酸テトラエチルアンモニ ウム/炭酸プロピレン溶液 (1M TEA BF<sub>4</sub>/PC 溶液)を使用した。 1 M TEA BF<sub>4</sub>/PC 溶液の導電率 $k_s$ は13 mS/cmである (Alan et al., 1999)。

#### 2.4 アルミニウム箔旗型電極の化成処理

アルミニウム旗型電極に酸化アルミニウムの皮膜を作成す る化成処理は電流規制モードで行った。図1(b)に示すように、 アルミニウム旗型電極は対極である白金電極の中央に位置す るように組み立てた。さらに図2に示すように、電解液であ る0.3 Mアジピン酸アンモニウム水溶液をトールビーカに入 れて、テフロンキャップで電極を固定して蓋をして、電池式 AI | 0.3M AA aq | Ptの化成処理セルを組み立てた。ガルバ ノスタット(HA-151,北斗電工)を使用して、目標電圧Vまで、 化成セルに電流/=+0.1 mAを通電した。目標電圧Vは酸化ア ルミニウムの皮膜厚みdが1.4 nm、4.2 nm、5.6 nm、7.0 nm に対応する1V、3V、4V、5Vとした。



図1:アルミニウム旗型電極の形とセルの電極位置



図2:電解セルの概略図

2.5 サイクリックボルタモグラムによる拡面倍率 G<sub>I</sub>の測定

拡面倍率G<sub>0</sub>の測定にはサイクリックボルタンメトリーで 得られた電流/を用いて算出した。作用極にアルミニウム旗 型電極、参照極に銀、対極に白金、電解液に0.3Mアジピン 酸アンモニウム水溶液を用いて2.4のアルミニウム箔旗型電 極の化成処理と同様の手順で電池式 AI | 0.3 M AA ag | Pt vs. AgのCVセルを組み立てた。ポテンショスタット(HA-151,北 斗電工)とファンクションジェネレータ(HB-111,北斗電工)を 使って、CVセルに電位EがOCVから+5Vまで掃引速度v=0.1 V/sでアノード掃引した。さらに、電位E = 5 Vで折り返し、 電位 E = -1.5 V まで掃引速度 v = -0.1 V/s でカソード掃引した。 電位掃引と同時に、XY-レコーダ(WX1200, GRAPHTEC)を使 用して電流/を記録した。それぞれのアルミニウム旗型電極 において,アノード掃引時の電位E = 1.5 Vになったときの電 流/を読み取った。未処理箔のアルミニウム旗型電極の電流 を10、未処理箔以外の電流/を/として、式(3)に代入して拡面 倍率G<sub></sub>を算出した。

$$G_1 = I / I_0$$
 (3)

#### 2.6 静電容量による拡面倍率の測定

拡面倍率 $G_c$ はアジピン酸アンモニウム水溶液中でアルミニ ウム箔の静電容量Cから算出した。作用極にアルミニウム箔 旗型電極を、対極にステンレスビーカー (内径 54 mm)を用い て、電池式AI | 0.3 M AA aq | SUSの静電容量セルを作成した。 静電容量Cの測定にはLCRメーター (ZM2355, NF回路設計ブ ロック)を使用した。オシロスコープ (54622A, Agilent)を使 用してバイアス電圧 $V_b$ と電圧振幅 $V_a$ を確認しながら静電容量 Cを測定した。測定条件は周波数 $f_c$  = 220 Hz、電圧振幅 $V_a$  = 500 mV<sub>PP</sub>、バイアス電圧 $V_b$  = 2 Vであった。LCRメーター固 有の設定パラメーターは、CKT = オートシリアル、スピード = MID2であった。未処理箔のアルミニウム旗型電極の静電容 量を $C_o$ 、未処理箔以外の旗型電極の静電容量をCとして、式(4) に代入して拡面倍率 $G_c$ を算出した。

$$G_{\rm c} = C / C_0$$

(4)

#### 2.7 接触抵抗の測定

接触抵抗 $R_c$ の測定には本田らが提案したクロノポテンショ メトリーを用いた(本田他, 2013; Honda et al., 2014)。作用極 に合材電極、参照極に銀、対極に白金、電解液に1 M TEA BF<sub>4</sub>/ PC溶液を用いて2.4のアルミニウム箔旗型電極の化成処理と 同様の手順で電池式AI | 電極合材 | 1M TEA BF<sub>4</sub>/PC溶液 | Pt vs. AgのCPセルを組み立てた。CPセルに、ガルバノスタット (2020, 東方技研)とファンクションジェネレータ(WH1945B, NF 回路設計ブロック)を使用して、周波数 $f_{cp}$  = 0.1 Hz、 $I_c$  = 2.0 mA<sub>p-p</sub>の矩形波電流を印加し、電位応答をXY-レコーダに記録 した。電流反転時の直線的に降下した電位差  $\Delta E$  を印加電流 $I_c$ = 2.0 mA<sub>p-p</sub>で割り、内部抵抗 $R_i$ を算出した。印加電流 $I_c$ は20  $\mu$ A<sub>p-p</sub>、200  $\mu$ Ap-p、2 mA<sub>p-p</sub>で測定し、内部抵抗 $R_i$ の算出には  $I_c$  = 2 mA<sub>p-p</sub>の電位差  $\Delta E$  を使用した。

溶液抵抗R<sub>a</sub>は、交流インピーダンス法により高周波側の実 軸切片を読み取り、溶液抵抗R<sub>a</sub>を算出した。式(5)に示すよ うに内部抵抗R<sub>i</sub>から溶液抵抗R<sub>a</sub>を引き、電極面積Sを乗算し、 接触抵抗R<sub>a</sub>を算出した。

$$R_c = (R_i - R_s) \times S \tag{5}$$

#### 3. 結果と考察

#### 3.1 拡面倍率の測定

図 3に示した前処理の異なるアルミニウムの0.3 Mアジピン酸アンモニウム水溶液中でのサイクリックボルタモグラムを示す。図 3(a)に示すようにアルカリ脱脂をした未処理箔をアノード掃引した場合には+0.25 mAの電流/が流れた。このことから電位反転までに生成する皮膜は電流効率100%を仮定すると電気量qに換算して13 mCであり、皮膜の厚みdは5.5 nmであると推定される。図 3(b)に示すようにアルカリ脱脂をしたa箔においてアノード掃引した場合には+0.70 mAの電流が流れた。a箔の電流値は未処理箔に対して3倍であり、そのまま拡面倍率Gを示していると考えられる。図 3(c)に示すようにa箔においては0 V付近から急激な電流上昇が見られ、電位E = 1.5 Vで電流/= 3.0 mAを示した。図 3(d)に示すようにアルカリ脱脂をしたb箔においてアノード掃引した場合には0 Vで電流/が流れ始め、0.5 Vから1.5 Vにおいて+0.50 mA の平坦部が見られ、2 V付近で急激に電

流/が流れ、2.3 Vで+16 mA、2.5 Vで+13 mA、2.8 Vで+18 mAの電流/が流れ、下降していった。3.5 Vから5 Vにかけて+1 mAの平坦部が見られた。図 3(e)に示すようにb箔においてアノード掃引した場合には電位Vが2 V~3 Vで+18 mAの電流/が流れた。未処理箔に対して70倍近い電流/が流れた。

酸化アルミニウムの生成反応式を式(6)に示す(小沢, 1990)。

$$2AI + 3H_2O \rightarrow AI_2O_3 + 6H^+ + 6e^-$$
(6)

酸化アルミニウムのアノダイジングレシオaは1.36 nm/V であり(立花他,2001)、掃引速度v = 0.1 V/s、電極面積S = 100 mm<sup>2</sup>、酸化アルミニウムの密度 $\delta = 3100$  kg/m<sup>3</sup>(立花他, 2001)、酸化アルミニウムの式量m = 101.96 g/mol、ファラ デー定数F = 96485 C/mol として、式(7) に代入すると、拡面 倍率が1の電流値が求まり、電流/=0.24 mA に相当する。

$$I = a \times v \times S \times \delta \div m \times F \times 6 \tag{7}$$

未処理箔の電流/が0.18 mAであり、旗型に切り出し時の誤 差を考慮し、電極の縦と横の長さが $7 \pm 0.5$  mmであると仮定 すると、電極面積5 が $86 \sim 120$  mm<sup>2</sup>になり、理論電流/は0.21~ 0.28 mAになる。未処理箔の電流/=0.18 mAは実験事実と して妥当な値であり、未処理箔の拡面倍率Gを1として計算 するのが妥当であると判断した。

表 2にアルミニウムの静電容量*C*と拡面倍率*G*を示す。電流から求めた拡面倍率 $G_i$ は、電位*E* = 1.5 Vの電流/から算出した。静電容量*C*から求めた拡面倍率 $G_c$ は、a箔が33、b箔が4.5 であり、電流から求めた拡面倍率 $G_i$ はa箔が10、b箔が1~2 であった。a箔は粗面化処理によってアルミニウム箔の表面が多孔質化して拡面倍率Gが増加している。一方、b箔は拡面倍率 $G_i$ が1~2 であった。

図4に前処理の異なるアルミニウム表面のSEM写真を示す。 図4(a)に示すように、原箔、b箔の5000倍に拡大した表面 形状を観察したところ、ポアは見当たらなかった。一方、図 4(b)に示すようにa箔の5000倍に拡大した表面形状を観察し たところ、大きさが数百nmから数µmのポアがまだらに存



図3:前処理の異なるアルミニウムのボルタモグラム

表 2: アルミニウムの静電容量Cと拡面倍率G

アルミニウムの種類	静電容量C/µF	静電容量による拡面倍率 $G_{c}$	電流から求めた拡面倍率 $G_1^*$
未処理箔	1.0	1.0	1.0
a箔	33	33	10
b箔	4.5	4.5	$1.5\pm0.5$
未処理箔アルカリ脱脂	2.2	2.2	1.4
a箔アルカリ脱脂	6.5	6.5	3.9
b箔アルカリ脱脂	10	10	$4.2 \pm 1.4$

注:\* $G_1$ は電位E = 1.5Vの電流/を用いて算出した。



原箔, b箔

a箔

図4:表面処理の異なるアルミニウム箔のSEM写真

在していた。これは活物質の粒径より小さく、炭素材料の粒 径より大きい。

#### 3.2 接触抵抗の測定

図 5(a) に未処理箔のセルのクロノポテンショグラムを示 す。定常状態にするために、事前に電流/=+1 mA, 5秒後 に/=-1 mA さらに5秒後に/=+1 mAの電流を流す操作を 数十秒間繰り返した。時刻t=0秒として、電流/=+1 mAを 流すと電位Eが-2.3から急激に上昇し0.1秒後に+0.7 Vになっ た。その後、0.6秒まで弓なりに電位Eが上昇し、1.3 Vになっ た。さらに、3秒後には、2.0 Vまで上昇し、5秒後には、ほ ぼ横ばいで上昇し電位Eは、2.2 Vになった。5秒後に、電流 の向きを反転して電流/=-1 mAに流したところ、電位Eは -0.4 Vであった。弓なりに電位Eが減少して、10秒後には -2.3 Vになった。10秒後に電流を反転させ、/=+1 mAとす ると、電位Eは+0.8 Vに上昇した。内部抵抗 $R_i$ は、1 mAか



図5:クロノポテンショグラム

ら-1 mAに電流を切り替えたときの電位差 $\Delta E = 2.6$  Vを印加 した電流振幅2 m $A_{p-p}$ で割って求め、1.3 k $\Omega$ となった。交流 インピーダンス法より溶液抵抗 $R_s$ を算出したところ20  $\Omega$ で あった。溶液抵抗 $R_s = 20 \Omega$ 、電極面積 $S = 100 \text{ mm}^2$ として、 式 (5) に代入し、接触抵抗 $R_c$ を計算すると130 m $\Omega$ m<sup>2</sup>となっ た。

図 5(b)に示すようにa箔のセルのクロノポテンショグラム を示す。a箔も同様に数十秒間電流の切り替えを繰り返し、 定常状態にしたのちの時刻を時間t=0秒として、測定した。 電流/=+1 mAを流すと電位Eが急激に上昇し、0.1秒後に電 位Eは-0.5 Vになった。さらに電位Eは上昇し、0.5秒後に電 位Eは+0.2 Vになった。2秒後,電位Eは0.75 Vになり、その 後弓なりに上昇し、5秒後に、電位Eは、0.95 Vになった。5 秒後に、電流の向きを反転して電流/=-1 mAに流したとこ ろ、電位Eは急激に減少し+0.45 Vであった。6.5 秒後に電位 Eは0 Vになり、7.5秒後には-0.75 Vであった。その後弓なり に減少し10秒後には電位Eは-1.3 Vであった。10秒後に電流 /を反転させ、/=+1 mAとすると、電位Eは-0.45 Vに上昇した。 内部抵抗Riは、1 mAから-1 mAに電流を切り替えたときの 電位差  $\Delta E_{\rm b} = 0.50$  Vを印加した電流振幅 2 mA<sub>p-p</sub>で割って内部 抵抗R<sub>i</sub>を求め、250 Ωとなった。溶液抵抗R<sub>s</sub> = 20 Ω、電極面 積*S* = 100 mm<sup>2</sup>として、式(5) に代入して、接触抵抗*R* を求 めたところ23 mΩm<sup>2</sup>となった。

図 5(c)に示すようにb箔のセルのクロノポテンショグラム を示す。b箔も同様に数十秒間電流の切り替えを繰り返し、 定常状態にしたのちの時刻を時間t = 0秒として、測定した。 電流/=+1 mAを流すと電位Eが弓なりに上昇し、5秒後に、 電位Eは、0.38 Vになった。5秒後に、電流の向きを反転して 電流/=-1 mAに流したところ、電位は急激に減少し+0.28 V であった。反転後、電位Eは、弓なりに減少し10秒後には、 -0.63 Vになった。10秒後に電流Iを反転させ、/=+1 mAとす ると、電位Eは-0.58 Vに上昇した。内部抵抗 $R_i$ は、1 mAか ら-1 mAに電流を切り替えたときの電位差 $\Delta E$  = 0.10 Vを印加 した電流振幅2 mA<sub>pp</sub>で割って内部抵抗 $R_i$ を求め、50  $\Omega$ となっ た。溶液抵抗 $R_s$  = 20  $\Omega$ 、電極面積S = 100 mm<sup>2</sup>として、式(5) に代入して、接触抵抗 $R_c$ を求めたところ3 m $\Omega$ m<sup>2</sup>となった。

表2に示した静電容量から拡面倍率 $G_c$ と接触抵抗 $R_c$ を比較 すると、a箔の拡面倍率 $G_c$ は33倍であるのに対し、接触抵抗  $R_c$ は、33分の1にはならなかった。ゆえに、拡面倍率 $G_c$ す なわち合材と集電体の接触面積を増加しても接触抵抗 $R_c$ の軽 減には寄与しない。接触抵抗 $R_c$ は拡面倍率 $G_c$ では説明でき ない。

#### 3.3 皮膜厚さと接触抵抗・抵抗率

図 6に、縦軸に接触抵抗 $R_c$ 、横軸に皮膜厚さdをとった表面処理の違いによる接触抵抗 $R_c$ の関係を示す。図 6(a)に示すように、未処理箔はアルミニウムの皮膜厚さdが0 nmのとき、接触抵抗 $R_c$ は190 m $\Omega$ m<sup>2</sup>を示した。皮膜厚さdが増加するに従って接触抵抗 $R_c$ も増加し、d=7 nmのとき、接触抵抗 $R_c$ は530 m $\Omega$ m<sup>2</sup>であった。図 6(b)に示すように、a箔はアルミニウムの皮膜厚さdが0 nmのとき、接触抵抗 $R_c$ は35 m $\Omega$ m<sup>2</sup>を示した。皮膜厚さdが0~4.2 nmまで、接触抵抗 $R_c$ が急激に増加し、d=7 nmのときの接触抵抗 $R_c$ は310 m $\Omega$ m<sup>2</sup>を示した。図 6(c)に示すように、b箔はアルミニウムの皮膜厚さdが0 nmのとき、接触抵抗 $R_c$ は3 m $\Omega$ m<sup>2</sup>を示した。皮膜厚さdが0 nmのとき、接触抵抗 $R_c$ は3 m $\Omega$ m<sup>2</sup>を示した。皮膜厚さdが0 nmのとき、接触抵抗 $R_c$ は3 m $\Omega$ m<sup>2</sup>を示した。皮膜厚さdが0 nmのとき、接触抵抗 $R_c$ には比例の関係があり、d=7 nmのとき、接触抵



図6:表面処理の違いによる皮膜厚さdと接触抵抗R。

 $抗 R_c tal 29 m \Omega m^2 を示した$ 

小野寺らは純度 99.99 %のアルミニウムと、マンガン酸リ チウムと炭素導電助材の接触抵抗 $R_c$ は式 (8) で示され、抵抗 率 $\rho$ は皮膜厚さdと接触抵抗 $R_c$ の傾きから求められると述べ ている (Onodera et al., submitted)。

 $R_{c} = \rho \left(d + d_{0}\right)$   $\rho d_{0} = 80 \text{ m}\Omega\text{m}^{2}$ (8)

図 6 (a)から未処理箔の抵抗率 $\rho$ は48 M $\Omega$ mであり、図 6 (b) から a 箔の抵抗率 $\rho$ は40 M $\Omega$ m、図 6 (c)から b 箔の抵抗率 $\rho$ は4.3 M $\Omega$ mであった。図 6 (d) ~ (f)に示すアルカリ脱脂をし た未処理箔、a 箔、b 箔の近似曲線はフリーハンドによる推定 である。

表 3にアルミニウム集電体の種類と抵抗率 $\rho$ の関係を示す。 未処理箔の抵抗率 $\rho$ は48 M  $\Omega$  m, a箔は40 M  $\Omega$  m、b箔は4.3 M  $\Omega$  m であった。アルカリ脱脂をした未処理箔、a箔、b箔の 抵抗率 $\rho$ はそれぞれ150 M  $\Omega$  m、68 M  $\Omega$  m、27 M  $\Omega$  m であっ た。相互拡散層がない未処理箔とa箔の抵抗率 $\rho$ と比較して、 相互拡散層があるb箔では抵抗率 $\rho$ が10分の1になっている。 小野寺らの報告によるアルミニウム箔の酸化皮膜の抵抗率 $\rho$ は110 M  $\Omega$  m であり(Onodera et al., submitted)、b箔の抵抗 率 $\rho$ はアルミニウム箔表面の相互拡散層の寄与により抵抗率  $\rho$ が大幅に軽減されている。

表3:アルミニウム集電体の種類と抵抗率の関係

アルミニウム集電体の種類	接触抵抗 $R_c/m\Omega m^2$	抵抗率 $\rho/M\Omega$ m
未処理箔	$130 \sim 260$	48
a箔	$23 \sim 46$	40
b箔	3	4.3
未処理箔アルカリ脱脂	140	150
a箔アルカリ脱脂	$10 \sim 31$	68
b箔アルカリ脱脂	6	27

表面処理には寄与率cを変化させる処理として形状を変化 させる処理がある。その一つが粗面化処理であり、粗面化処 理を施したa箔は未処理箔と比較して抵抗率ρは大幅な違い がないが、接触抵抗R<sub>c</sub>は5分の1になっている。

$$R_{c} = \left(\rho_{0} \sum_{i} c_{i} \chi_{ei} + \rho_{0}^{'}\right) (d + d_{0})$$

$$\sum_{i} c_{i} = 1$$
(9)

図 7にアルミウム集電体と合材の接触モデルを示す。それ ぞれ 図 7 (a)はアルミウム集電体と電解液が接しているモデ ル、図 7 (b)はアルミウム集電体と炭素材料が接しているモ デル、図 7 (c)はアルミウム集電体と活物質と炭素材料を含む 合材が接しているモデル、図 7 (d)は図 7 (c)のアルミウム集 電体に炭素アンダーコートを施したモデル、図 7 (e)は図 7 (c) の活物質をカーボンナノチューブで覆ったモデル、図 7 (f)は 図 7 (c)のアルミウム集電体に相互拡散層を設けたモデル、図



(d) アンダーコート

(e) カーボンナノチューブによる電荷遮蔽

(f)相互拡散層による電荷遮蔽



図7:アルミニウム集電体と接触モデル 注:Cは炭素材料を示している。

7 (g) は図 7 (c) のアルミウム集電体を粗面化したモデルである。

図 7 (a) はアルミウム集電体と電解液が接しているモデルで ある。アルミウム集電体の上には不働態皮膜が形成している。 図中では酸化アルミニウムで示されているが、実際のリチウ ム電池ではフッ化アルミニウムを主とした不働態皮膜と考え られている(金子他, 2010; 遠山他, 2014) アノード酸化による 不働態皮膜はそれほど完全な結晶ではなく(金子他, 2010)、 アニオン欠損型の不定比化合物半導体となっていると考えら れる。しかしながら電解液に含まれる酸化物イオンやフッ化 物イオンなどのアニオンが吸着していると考えられる(金子 他, 2010)。アニオンは電荷を持って配向吸着するため、その 電気感受率Xeは極めて大きく、そのアニオンの電荷によって 形成される空乏層(空間電荷層)によって不働態皮膜中のキャ リアは表面から押しやられて不働態皮膜は絶縁体として観察 され、かつ電解液は電子絶縁体であるので、界面抵抗は極め て大きくなると考えられる。このような状態は式(9)における アニオンの電気感受率Xeの寄与率cが100%である状態と解 釈される。

図7(b)はアルミウム集電体と炭素材料が接しているモデル である。炭素材料は極性がなく、その中でもアセチレンブラッ クは官能基が少なく(和田, 2012)、その電気感受率X<sub>e</sub>はほぼ 0と考えられる。しかも炭素材料は電子導電性なので非常に 小さい接触抵抗 $R_c$ となると考えられる。このような状態は式 (9)における炭素材料の電気感受率 $\chi_e$ が0であり、かつその寄 与率cが100%である状態と解釈される。

図 7 (c)はアルミウム集電体と活物質と炭素材料を含む合材 が接しているモデルである。合材中に含まれる活物質はイオ ン結合を持ち、その表面にある電荷から極性があると考えら れる。その表面電荷によって不働態皮膜中のキャリアは表面 から押しやられて海島状の空間電荷層が形成されるため、図 7 (b)に較べて不働態皮膜中のキャリアが減少し接触抵抗R.が 大きくなると考えられる。表面電荷の多い活物質すなわち見 かけの比誘電率 ε が大きな表面を持つ活物質を使うと接触抵 抗Rcが大きくなるのはこのためと考えられる。従ってこの活 物質の表面電荷が不働態皮膜に及ぼす効果を遮蔽することで 接触抵抗R<sub>c</sub>を小さくできると考えられる。活物質の表面電荷 が不働態皮膜に及ぼす効果を遮蔽する手段としては、図7(d) のようにアルミウム集電体に炭素アンダーコートを施す、図 7 (e)のように活物質をカーボンナノチューブで被覆する、図 7(f)のようにアルミウム集電体に相互拡散層を設けるなどの 手段がある。このようにして活物質の表面電荷が不働態皮膜 に及ぼす効果を遮蔽した場合、活物質の電気感受率x。の寄与 率 c が 0% である状態と解釈される。

図 7 (d) は図 7 (c) のアルミウム集電体に炭素アンダーコートを施したモデルである。アルミウム集電体に炭素アンダーコートを施すことによって活物質の表面電荷が不働態皮膜に及ぼす効果は遮蔽され、結果として図 7 (b) と同程度まで接触抵抗 $\chi_e$ を小さくできると考えられる。この効果は見かけの比誘電率  $\varepsilon$  が大きな活物質ほど大きいと考えられる。

図 7 (e) は図 7 (c) の活物質をカーボンナノチューブで被覆 したモデルである。合材にカーボンナノチューブをうまく分 散することで活物質の表面電荷が不働態皮膜に及ぼす効果は 遮蔽され、結果として図 7 (b) と同程度まで接触抵抗R<sub>c</sub>を小 さくできると考えられる。

図7(f)は図7(c)のアルミウム集電体に相互拡散層を設けた モデルである。アルミウム集電体の不働態皮膜の表面に電子 導電層を設けることで活物質の表面電荷が不働態皮膜に及ぼ す効果は遮蔽され、結果として図7(b)と同程度まで接触抵抗 R<sub>c</sub>を小さくできると考えられる。このような不働態皮膜では 図3に示すように電解液に電子電流が流れるため、低い電位 で電子電流が流れる場合は電解液の劣化も懸念する必要があ る。

図 7 (g)は図 7 (c)のアルミウム集電体を粗面化したモデル である。炭素材料は活物質材料に較べて粒径が小さいのでポ アサイズを適切に制御することで、活物質のよる空間電荷層 の形成を局所的に制限することが可能になると考えられる。 その結果、図 7 (c)より接触抵抗R<sub>c</sub>を小さくできると考えら れる。このような状態は活物質の電気感受率X<sub>e</sub>の寄与率cを 100%より小さい状態と解釈される。なおアルミウム集電体 を粗面化しても、電極を通過する電流Iの経路、すなわち電 気力線の分布は変化しないため電流密度jは変化しない。よっ て接触抵抗R<sub>c</sub>が低減できる主たる理由は電極面積5が増大す ることにより電流密度jが小さくなることよりは活物質によ る空間電荷層の形成を局所的に制限したことによるものであると考えられる。

工業的な利用には、アンダーコートでは二度塗による工程 および人件費、カーボンナノチューブによる電荷遮蔽では、 カーボンナノ材料の価格、相互拡散相による電荷遮蔽では、 アルミニウム集電体箔の価格による製造コストの増加が懸念 される。これら3つの手法のトレードオフが急速充放電可能 なリチウム2次電池の開発のキーとなる。

#### 4. 結論

アルミニウム集電体の表面処理には粗面化などの物理的ア プローチと相互拡散層の形成などの化学的アプローチがある が、そのいずれも接触抵抗低減に効果が認められる。そして そのいずれも空間電荷層の形成によって説明できるが、接触 抵抗低減には相互拡散層の形成などの化学的アプローチの方 がはるかに効果的に作用する。

# 引用文献

- Alan, B. M. and Ein-Eli, Y. (1999). Nonaqueous electrolyte for electrical storage devices, US005965054A.
- Honda, C., Onodera, S., Tachibana, K., Nishina, T. (2012). The effect of the active material of lithium battery to the contact resistance between carbon and aluminum current, PRIME 2012 Joint International Meeting Honolulu, Hawaii, 222nd Meeting of ECS-The Electrochemical Society, 2012 Fall Meeting of The Electrochemical Society of Japan (ECSJ), Abstract #1097.
- Honda, C., Kikuchi, S., Ito, T., Onodera, S., Nagai, A., Ito, T., Tachibana, K. and Nishina, T. (2014). Evaluation of contact resistance of aluminum current collector surfaces for energy storage systems. *Electrochemistry*, Vol. 72, No. 5, 328-330.
- 本田千秋・立花和宏・仁科辰夫(2013). リチウムイオン二次 電池の電極塗工時に用いるバインダーの種類がアルミニウ ム集電体と合材の接触抵抗に及ぼす影響. 第54回電池討論 会予稿集, 185.
- 金子郁枝・柳沼雅章・遠藤淳一・立花和宏・遠藤孝志・仁科辰夫・ 村山勉(2010). アルミニウムの表面酸化皮膜が有機電解液 中でのアノード酸化に及ぼす効果. 表面技術, Vol. 61, No. 4, 330-333.

小沢昭弥監修(1990).現代の電気化学.新星社.

- Onodera, S., Kato, N., Ito, T., Ito, T., Tachibana, K. and Nishina, T. (2014). Effect of degree of dispersion of positive electrode containing carbon nanotubes with same composition on contact resistance of lithium ion secondary battery. *Electrochemistry*, (submitted).
- 立花和宏・佐藤幸裕・仁科辰夫・遠藤孝志・松木健三・小野 幸子 (2001). リチウム電池駆動用電解液中におけるアルミ ニウムの不働態化 (1). 皮膜生成機構, *Electrochemistry*, Vol. 69, No. 9, 670-680.
- 遠山達哉・高橋心・藤枝正・高橋良幸・木村尚貴・青柳拓也 (2014). 全固体リチウムイオン二次電池, WO 2014068777

A1.

和田徹也 (2012). 二次電池導電助剤としてのカーボン材料設計. 粉砕, No.55, 58-62.

(受稿:2014年12月11日 受理:2014年12月16日)